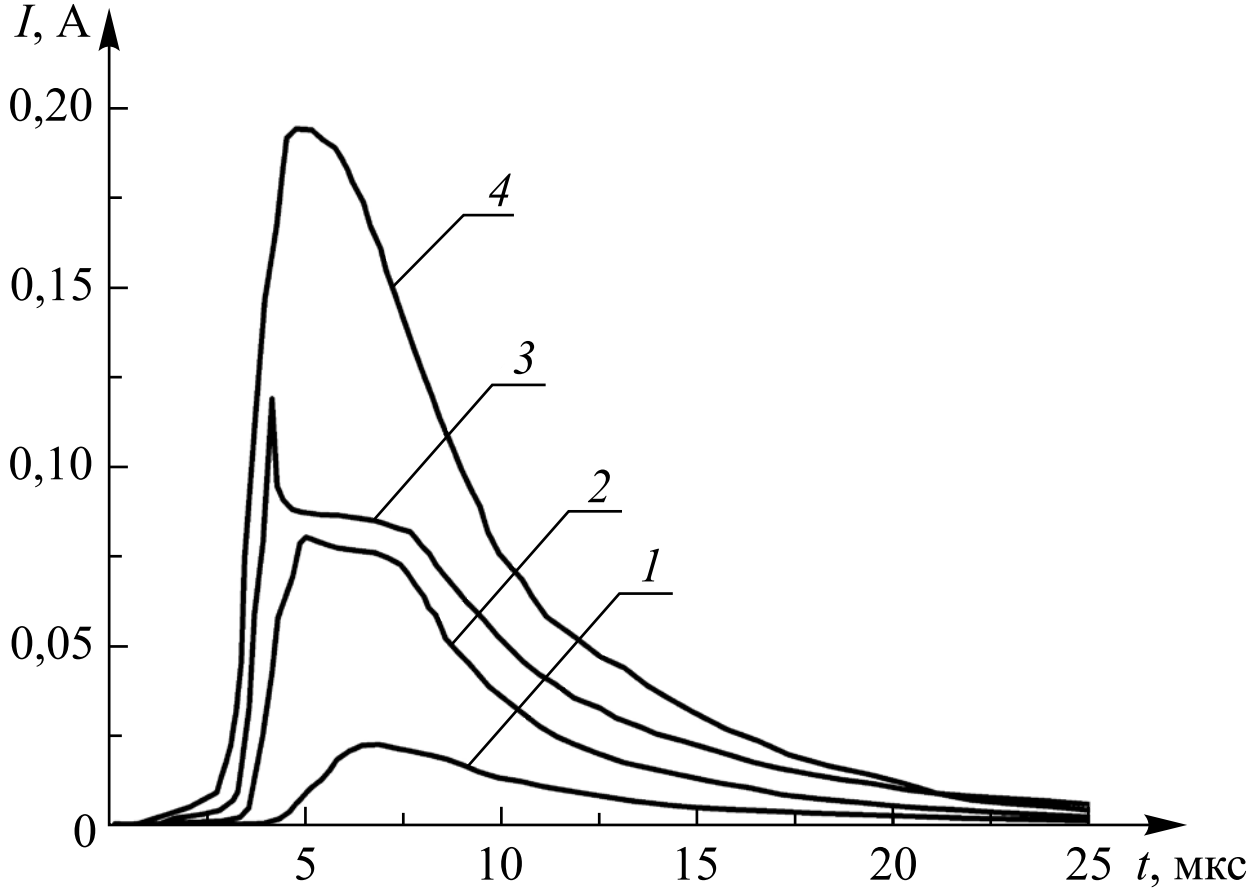


Рис. 3. Ток на кремниевой подложке КДБ03 при различных плотностях мощности воздействующего на медную мишень лазерного излучения и разных потенциалах в промежутке сетка – подложка (на участке мишень – сетка установлен постоянный потенциал $U_1 = 30$ В):
1 – $1{,}5 \cdot 10^9$ Вт/см^2, $U_2 = 50$ В; *2* – $1{,}7 \cdot 10^9$ Вт/см^2, $U_2 = 50$ В;
3 – $1{,}8 \cdot 10^9$ Вт/см^2, $U_2 = 50$ В; *4* – $1{,}8 \cdot 10^9$ Вт/см^2, $U_2 = 100$ В

Fig. 3. Current on a silicon substrate KDB03 at acting laser radiation on a copper target at different power densities and at different potentials in the grid – substrate interval (the interval target – grid have constant potential $U_1 = 30$ V): *1* – $1.5 \cdot 10^9$ W/cm^2, $U_2 = 50$ V; *2* – $1.7 \cdot 10^9$ W/cm^2, $U_2 = 50$ V; *3* – $1.8 \cdot 10^9$ W/cm^2, $U_2 = 50$ V; *4* – $1.8 \cdot 10^9$ W/cm^2, $U_2 = 100$ V